

本件は、本日、韓国、米国においても発表いたします。

2011年11月15日

## 韓国企業をCMPスラリーに関する特許権侵害で提訴

日立化成工業株式会社(本社:東京、執行役社長:田中 一行、資本金:155億円)は、K. C. Tech Co., Ltd.(本社:韓国ソウル市、以下、K. C. Tech)が、半導体ウエハの化学的機械研磨(CMP)に使用する酸化セリウムスラリー(以下、CMP スラリー)に関する当社の米国特許を侵害しているとして、米国テキサス州オースティンの西部地方裁判所に提訴しました。

当社は、K. C. Tech と 2010 年 6 月から問題解決に向け、和解条件等について協議を続けてまいりましたが、合意に至りませんでした。当社の特許を侵害している K. C. Tech から、知的財産を保護し、特許使用料の支払いを求めるため、今般、提訴に踏み切りました。K. C. Tech の CMP スラリー「KCS-3100」が侵害していると判断した当社の米国特許は、USP7,115,021 と USP7,871,308 の 2 件です。

CMP スラリーは、半導体の平坦化工程に使用される研磨液で、化学的研磨と機械的研磨を同時に行い、半導体ウエハの平坦度を高めて、工程時間を減らすことができます。当社は半導体業界の発展のため、CMP の革新的な製品および製法の開発に取り組んでおり、豊富な製品ラインアップ、高い品質信頼性や、優れた技術サポートから、当社の CMP スラリーはワールドワイドで多くのお客さまにご使用いただき、STI(Shallow Trench Isolation)\*用においてはトップシェアを有しております。上記 2 件の米国特許も、当社の研究開発努力により取得したものです。

今後も知的財産面からの事業の優位性も図るため、当社は特許およびその他の知的財産を保護し、積極的に権利行使していきます。

\*STI: シリコンウエハ上の何百万個もの半導体素子をそれぞれ電氣的に絶縁する「素子分離」の方法の一つ。微細配線に適していることからデザインルール 180 ナノメートル近辺から主流になってきました。

以上